


	<p>Hersteller-Teilenummer: BSB028N06NN3GXUMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2</p>
	<p>Datenblätter:  BSB028N06NN3GXUMA1.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSB028N06NN3GXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 102µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Andere Namen	BSB028N06NN3 GCT
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	143nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 22A (Ta), 90A (Tc) 2.2W (Ta), 78W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Ta), 90A (Tc)

BSB028N06NN3GXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB028N06NN3GXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB028N06NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB028N06NN3GXUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSB053N03LP G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO</p>	 <p>BSB024N03LXG INFINEO BSB024N03LXG INFINEO</p>	 <p>BSB028N06NN3G INFINEO BSB028N06NN3G INFINEO</p>	 <p>BSB044N08NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2</p>
 <p>BSB044N08NN3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2</p>	 <p>BSB022NE2LX G INFINEO BSB022NE2LX G INFINEO</p>	 <p>BSB053N03LTG INFINEO BSB053N03LTG INFINEO</p>	 <p>BSB028N06NN3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB028N06NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB028N06NN3GXUMA1 Datenblatt	BSB028N06NN3GXUMA1-Datenblätter	BSB028N06NN3GXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
BSB028N06NN3GXUMA1 Electronic	BSB028N06NN3GXUMA1-Komponenten	BSB028N06NN3GXUMA1-Verteiler	BSB028N06NN3GXUMA1-Bild	BSB028N06NN3GXUMA1
BSB028N06NN3GXUMA1 Aktie	BSB028N06NN3GXUMA1 Inventar	BSB028N06NN3GXUMA1 Preis	BSB028N06NN3GXUMA1 Hersteller	BSB028N06NN3GXUMA1-Teil
BSB028N06NN3GXUMA1 RFQ	BSB028N06NN3GXUMA1 Online bestellen	BSB028N06NN3GXUMA1 Neu	BSB028N06NN3GXUMA1 Original	BSB028N06NN3GXUMA1 Bild
				BSB028N06NN3GXUMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited